



### 一种氧化石墨烯还原制备石墨烯材料的方法

文献类型: 专利

**作者** 杜金红, 裴嵩峰, 赵金平, 任文才 and 成会明

**发表日期** 2011-12-14

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明涉及石墨烯材料领域,具体为一种新的氧化石墨烯(GrapheneOxide,GO)还原制备石墨烯材料的方法,适用于各种基于氧化石墨烯的粉体和薄膜材料的还原。将氧化石墨烯制品在以氢碘酸、氢溴酸和氯化亚砷等为代表的卤化试剂中、-5到140°C的温度范围内浸泡10秒~24小时,取出干燥后即可完成对氧化石墨烯材料的还原,还原后得到的石墨烯材料具有优异的导电性并可保持薄膜制品的柔韧性。本发明方法简单、易控,可实现氧化石墨烯材料的低温、高效、大量、低成本还原,解决现有技术中存在的环境污染、成本高等问题。

**公开日期** 2011-12-14

**语种** 中文

**专利申请号** CN102275902A

**源URL** [http://210.72.142.130/handle/321006/67683]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 杜金红, 裴嵩峰, 赵金平, 任文才 and 成会明. 一种氧化石墨烯还原制备石墨烯材料的方法. 2011-12-14.  
**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
284	0	0

#### 其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。